

СВЕРХПРОВОДЯЩАЯ ШЕЛЬ, ПЛОТНОСТЬ СОСТОЯНИЙ И
КИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА $\text{La}_2\text{Sr}_3\text{Cu}_4\text{O}_{14}$ И $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$.

Б.А.Александров, С.В.Берховский, Б.Н.Гончарский, А.Ю.Деревсов,
А.Ю.Зуев, В.Л.Кожевников, В.Л.Константинов, К.Р.Крылов, А.Т.Лен-
чаков, К.Н.Михалев, А.Н.Петров, А.И.Пономарев, М.В.Садовский,
И.М.Шидильковский, В.И.Цидильковский, С.М.Чепницкий

Институт физики металлов, химии и электрохимии УрО АН СССР

На $\text{Y}_2\text{Ba}_3\text{Cu}_4\text{O}_{14}$ (образец 1) и $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ (образец 2) измерены сопротивление ρ ($4,2 \leq T \leq 300\text{K}$), эффект Холла ($T = 160\text{K}$) и термоздес α ($4,2 \leq T \leq 185\text{K}$). Ширина перехода в сверхпроводящее состояние для обр. 1 73–98К, для обр. 2 86–93К (рис. I). У обр. 1 в интервале 98–300 ρ убывает от $9,3 \cdot 10^{-3} \Omega\text{м}\cdot\text{см}$ до $7,3 \cdot 10^{-3} \Omega\text{м}\cdot\text{см}$, у обр. 2 в интервале 93–160К ρ растет от $6,5 \cdot 10^{-4} \Omega\text{м}\cdot\text{см}$ до $9,5 \cdot 10^{-4} \Omega\text{м}\cdot\text{см}$. Оцененная по эффекту Холла концентрация дырок $p = (5 \pm 2,5) \cdot 10^{22} \text{ см}^{-3}$.

При переходе в нормальное состояние термоздес резко возрастает от нуля до $+(10-15)\text{мкВ}/\text{град}$, затем с повышением T до 110К возрастает, а выше 110К убывает (рис. I). Немонотонное изменение и, в особенности, убывание $\alpha(T)$ наблюдалось в условиях сильного рассеяния электронов $\hbar/\tau \gg \varepsilon_F$ (τ – время релаксации, ε_F – энергия Ферми). Как правило уровень Ферми при этом расположен на спаде пика плотности состояний, обусловленного перекрытием либо нескольких p - и d -зон ($\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$), либо примесной зоны с зоной проводимости (Ge).

Для обр. 2 с $p = 5 \cdot 10^{22} \text{ см}^{-3}$ подвижность $R_S \approx 0,17 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$, масса дырок $m \approx 10m_e$ (m_e – масса свободного электрона), $\varepsilon_F \approx 0,5 \text{ эВ}$, $a(\hbar/\tau) \approx 0,7 \text{ эВ} \gg \varepsilon_F$. Поэтому формулы для ρ и α , полученные на основе уравнения Больцмана, неприменимы. Попытаемся качественно объяснить зависимости $\rho(T)$ и $\alpha(T)$. Будем считать, что вблизи уровня Ферми плотность состояний $g(\varepsilon)$ можно представить как сумму плавно и резко меняющихся частей $g_0(\varepsilon)$ и $g_1(\varepsilon)$. Пусть $g_1(\varepsilon)$ имеет вид пика шириной V , вершина которого расположена при $\varepsilon = \varepsilon_0$. Для анализа $\alpha(T)$ и проводимости $\sigma(T)$ используем формулы [I]

$$\sigma \sim \int \delta(\varepsilon) \left(-\frac{\partial f}{\partial \varepsilon} \right) d\varepsilon, \quad d = \frac{K}{e^2} \int \delta(\varepsilon) \frac{\varepsilon - \varepsilon_F}{kT} \left(-\frac{\partial f}{\partial \varepsilon} \right) d\varepsilon, \quad (1)$$

где $\delta(\varepsilon) \sim |\mathcal{D}(\varepsilon)|^2 g^2(\varepsilon)$, f функция Ферми, $\mathcal{D}(\varepsilon)$ матричный элемент. Соответственно представлению $g = g_0 + g_1$ запишем δ и d в виде:

$$\delta = \delta_0 + \delta_1, \quad d = \delta^{-1} (\delta_0 d_0 + \delta_1 d_1). \quad (2)$$

С точностью до членов $\sim (kT/\varepsilon_F)^2$ $\delta_0(T) = \delta_0(\varepsilon_F) [1 + a_0(kT/\varepsilon_F)^2]$ и $d_0(T) = (K/e) \delta_0(kT/\varepsilon_F)$. Знаки чисел a_0 и b_0 совпадают со знаками $(\partial \delta_0 / \partial \varepsilon)_{\varepsilon_F}$ и $(\partial \delta_0 / \partial \varepsilon)_{\varepsilon_F}$.

Если пик $g_1(\varepsilon)$ близок к уровню Ферми и достаточно высок, и узок, основной вклад в интегралы (1), определяющий δ_1 , вносят узкие полоски энергий, центры которых ε_m сдвинуты относительно ε_F в сторону пика $g_1(\varepsilon)$. При малом сдвиге $|E_m - E_F| < kT$ с точностью до δ^2 ($\delta = kT(E_0 - E_F)/V^2 \ll 1$) $\delta_1 = C_1 + C_2 \delta^2$, $d_1 = C_3 \frac{K}{e^2} \delta$. Коэффициент C_2 может быть положительным или отрицательным, а $C_3 > 0$. Знак d_1 определяется знаком разности $E_0 - E_F$.

Полная термозадача $d(T)$ может иметь максимум (см. (2)), если знаки d_0 и d_1 (в условиях опыта $E_0 < E_F$, и $d_1 < 0$) противоположны и δ_1 / δ_0 растет с температурой.

Эффективную массу дырок m можно оценить, полагая, что при низких температурах $d \approx d_0 = \frac{\pi^2 K}{3} \frac{K}{e^2} \frac{K}{\varepsilon_F} s$, где $\frac{\pi^2}{3} s = b_0$, $s = d \ln \delta_0(\varepsilon) / d \ln \varepsilon$. Если $g_0 \sim \varepsilon^{1/2}$, а $|\mathcal{D}(\varepsilon)|^2 \sim \varepsilon^0$ или $\sim \varepsilon$, то $s = 1$ или 2. Тогда из (3) для $s=2$ и $p = 5 \cdot 10^{22} \text{ см}^{-3}$ и $T = 95 \text{ К}$ имеем $(m/m_0) \approx 10$ (обр. 1) и $(m/m_0) \approx 19$ (обр. 2). Для $s=1$ значения m/m_0 вдвое больше.

На трех образцах $YBa_2Cu_3O_7$ с помощью Фурье-спектрометра измерены спектры отражения в интервале 100 – 1000 см^{-1} при $4,2$ и 300 К (рис. 2, 3). Спектры нормированы на отражение от алюминиевого зеркала. В области гелиевых температур обнаружен хорошо воспроизводимый пик при $\nu = 458(3) \text{ см}^{-1}$, который исчезает в спектрах, снятых при 300 К . Считая, что этот пик связан с возбуждением носителей заряда через сверхпроводящую щель, $2\Delta/T_c = 7,6(6)$.

Анализ магнитной восприимчивости χ и скорости спин-решеточной релаксации ядер $(T_1)^{63}\text{Cu}$, ^{139}La , ^{139}Ba , ^{145}Sr , ^{63}Cu и ^{63}Si в $YBa_2Cu_3O_7$ позволил выделить спиновый вклад в χ . Для куприта лантана значения χ монотонно убывают от $0,77 \cdot 10^{-4} \text{ см}^3/\text{моль}$ (300К) до $0,65 \cdot 10^{-4} \text{ см}^3/\text{моль}$ (40К). Аналогично изменяется величина $(T_1 T)^{-1} R_s(300 \text{ К}) = 0,14(2) \text{ с}^{-1} \text{ К}^{-1}$, $R_{14}(40 \text{ К}) = 0,10(1) \text{ с}^{-1} \text{ К}^{-1}$,

$R_{\text{Cu}}(300\text{K})=0,25(3)\text{c}^{-1}\text{K}^{-1}$, $R_{\text{Cu}}(40\text{K})=0,14(2)\text{c}^{-1}\text{K}^{-1}$, несколько отклоняясь от корринговской зависимости $T_c, T = \text{const}$. Экстраполируя к нулю зависимость, мы получили оценки спинового вклада χ_s , связанного с плотностью состояний на уровне Ферми $\langle g_s(T) \rangle = \chi_s/2\mu^2$: $\chi_s(40\text{K})=0,27(3) \cdot 10^{-4} \text{ см}^3/\text{моль}$, $\chi_s(300\text{K})=0,40(3) \cdot 10^{-4} \text{ см}^3/\text{моль}$, $g_s(40\text{K})=0,40(5) (\text{эВ.ат. Cu спин})^{-1}$, $g_s(300\text{K})=0,60(5) (\text{эВ.ат. Cu спин})^{-1}$. При понижении T в нормальном состоянии происходит уменьшение спинового вклада χ_s и g_s , что, по-видимому, обусловлено структурным превращением из тетрагональной фазы в ромбическую. Для $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ значение χ больше: $\chi(300\text{K})=3,0(1) \cdot 10^{-4} \text{ см}^3/\text{моль}$, $\chi(90\text{K})=3,2(1) \cdot 10^{-4} \text{ см}^3/\text{моль}$. В области нормального состояния величина $(T_c, T)^{-1}_{\text{cu}}=3,1(3) \text{c}^{-1}\text{K}^{-1}$ постоянна. Предполагая постоянство значений сверхтонких полей на ядре ^{63}Cu в La-Sr-Cu-O и Y-Ba-Cu-O , можно утверждать, что при переходе к $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ плотность состояний, нормированная на атом меди, возрастает в $T_c^{1/2}(\text{LaSr})/T_c^{1/2}(\text{YBa})=4,5$ раза.

В области температур $T < T_c$ из-за уменьшения числа носителей с $\varepsilon > \varepsilon_F$ должен наблюдаться экспоненциальный рост T_1 : $T_1 \sim \exp(-\Delta/kT)$. В измерениях T_1 в смешанном состоянии важно учитывать факторы, связанные с различием величин энергетической щели и наличием градиентов магнитного поля между нормальной фазой в нитях Абрикосова ($\Delta=0$) и сверхпроводящей фазой ($\Delta=\Delta_0$), и с кроссрелаксацией ядер с $I > 1/2$ при большой ширине спектра ЯМР. Чтобы получить сведения о Δ_0 , необходимо выделять наиболее медленно нарастающую часть кривой восстановления ядерной намагниченности. На рис.4 даны зависимости $T_c(T)$ для ^{63}Cu , ^{139}La в изученных образцах. Наблюдаемый экспоненциальный рост соответствует $(2\Delta_0/T_c)=3,60(10)$ (^{63}Cu); $3,80(15)$ (^{139}La) для La-Sr-Cu-O и $8,0(5)$ (^{63}Cu) для Y-Ba-Cu-O . В системе $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$, вероятно, реализуется случай очень сильной электрон-фононной связи, когда T_c приближается к асимптотической зависимости $T_c \approx (0,1-0,2) \sqrt{\lambda \langle \omega^2 \rangle}$ [2].

Л и т е р а т у р а

- /1/ Н.Мотт, Э.Дэвис, Электронные процессы в некристаллических веществах, М., Мир, 1982.
- /2/ P.B.Allen,R.C.Dynes. Transition temperature of s-doped-coupled superconductors: reanalyzed. Phys. Rev. B12, N3, 905-922 (1975)

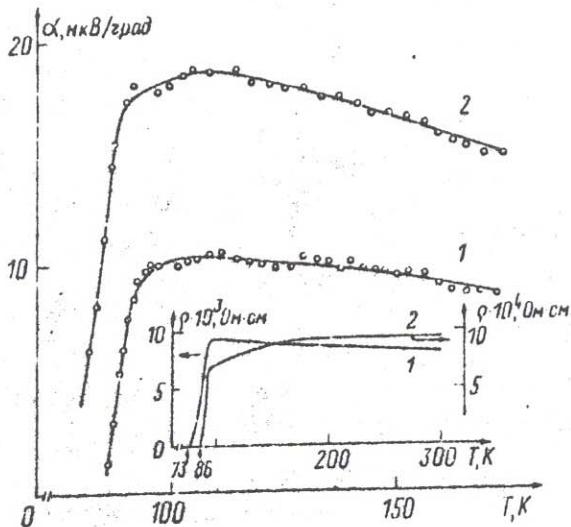


Рис. 1.

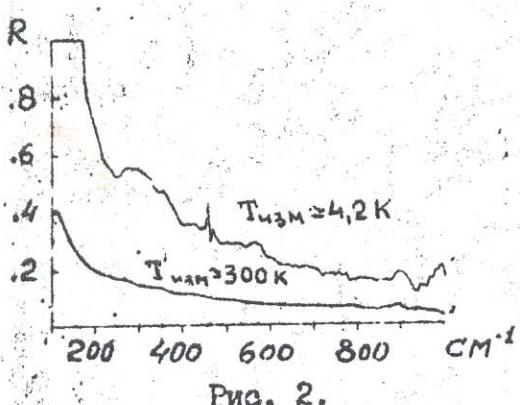


Рис. 2.

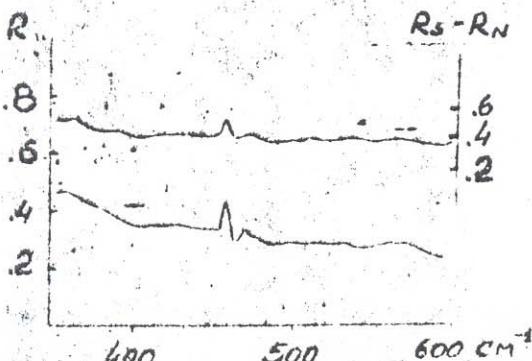


Рис. 3.

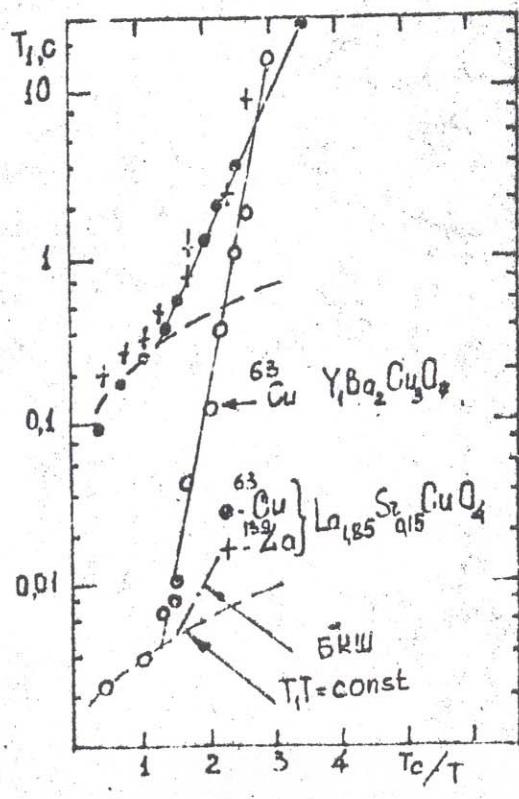


Рис. 4.